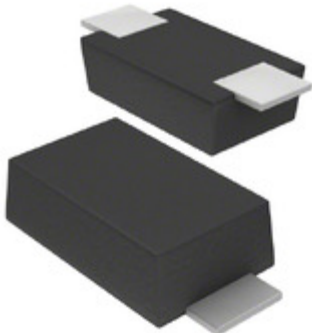


    Image may be representation. See specs for product details.	RF081M2STR Hersteller-Teilenummer: RF081M2STR Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 800MA PMDU Datenblätter:  RF081M2STR.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 309785 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	--

Spezifikationen

Teilenummer	RF081M2STR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 800MA PMDU
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	309785 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	950mV @ 800mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	PMDU
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOD-123
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	800mA
Kapazität @ Vr, F	-

Sie können auch interessiert

sein:



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

RF081M2SGTR

ROHM

RF081M2SGTR ROHM





RF081M2STF

ROHM

RF081M2STF ROHM





RF081MM2STF

ROHM

RF081MM2STF ROHM

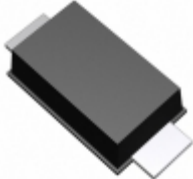




RF081M2STFE

ROHM

ROHM 2016+RoHS



RF081MM2STR

Rohm Semiconductor

DIODE GEN PURP 200V 800MA PMDU





RF081MM2S TR

ROHM

RF081MM2S TR ROHM



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

RF081M2SG TR

ROHM

ROHM SOD123





RF081M2STFTR

ROHM

ROHM SOD123

RF081M2STR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort				
RF081M2STR Lapisc Semiconductor	RF081M2STR Datenblatt	RF081M2STR-Datenblätter	RF081M2STR PDF	LAPIS Semiconductor RF081M2STR
RF081M2STR Electronic	RF081M2STR-Komponenten	RF081M2STR-Verteiler	RF081M2STR-Bild	RF081M2STR-Teil
RF081M2STR Preis	RF081M2STR Hersteller	RF081M2STR Bild	RF081M2STR Aktie	RF081M2STR Inventar
RF081M2STR Neu	RF081M2STR Original	RF081M2STR garantiert	RF081M2STR RFQ	RF081M2STR Online bestellen